

УДК 538.945:539.166

©1994

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ В СВЕРХПРОВОДНИКЕ $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4$

*В.Ф.Мастеров, П.П.Серегин, Ф.С.Насрединов, Н.П.Серегин,  
О.А.Приходько, Ч.С.Сайдов*

Методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопах  $^{61}\text{Cu}$ ( $^{61}\text{Ni}$ ) и  $^{67}\text{Cu}$ ( $^{67}\text{Zn}$ ) определены параметры тензора градиента электрического поля (ГЭП) в узлах меди решеток  $Nd_2\text{CuO}_4$  и  $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4$ . Показано, что согласование экспериментально определенных и рассчитанных (в приближении модели точечных зарядов) параметров тензора ГЭП может быть достигнуто, если электроны, появляющиеся в результате замещения ионов  $\text{Nd}^{3+}$  на  $\text{Ce}^{4+}$ , локализованы преимущественно в подрешетке меди.

Замещение ионов  $\text{Nd}^{3+}$  на  $\text{Ce}^{4+}$  в твердых растворах  $Nd_{2-x}Ce_x\text{CuO}_4$  приводит к возникновению высокотемпературной сверхпроводимости (при  $0.15 < x < 0.17$ ) [1], что связывается с появлением свободных электронов (в отличие от других высокотемпературных сверхпроводников типа  $\text{LaSrCuO}$  и  $\text{YBaCuO}$ , где свободными носителями заряда являются дырки). Пространственное распределение электронной плотности может быть определено путем сравнения экспериментальных и расчетных значений параметров тензора градиента электрического поля (ГЭП) в узлах решетки  $Nd_{2-x}Ce_x\text{CuO}_4$ . При этом может быть получена важная информация о том, в какой из энергетических зон сверхпроводника локализуются электроны. Существование узких зон, образуемых электронными состояниями, связанными с узлами определенного типа, позволяет надеяться на решение задачи такими «локальными» методами, как ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и мессбауэровская спектроскопия.

Методом ЯМР на изотопе  $^{63}\text{Cu}$  была измерена постоянная квадрупольного взаимодействия  $e^2Qq$  для центров меди в решетке  $Nd_{2-x}Ce_x\text{CuO}_4$  [2–6] и показано, что переход к сверхпроводящей фазе ( $x > 0.14$ ) приводит к исчезновению эффектов квадрупольного взаимодействия в спектрах ЯМР (здесь  $Q$  — квадрупольный момент ядра  $^{63}\text{Cu}$ ,  $eq$  — главная компонента тензора ГЭП на ядрах  $^{63}\text{Cu}$ ). Очевидно, это может быть описано в рамках одной из трех моделей: перестроением локального окружения атомов меди, перестроением электронной структуры атомов меди, одновременным перестроением электронной структуры и локального окружения атомов меди. В настоящее время отсутствуют убедительные доказательства справедливости той или иной модели.

Для определения пространственного распределения электронного заряда в решетке  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_4$  нам казалось целесообразным использовать эмиссионную мессбауэровскую спектроскопию на изотопе  $^{67}\text{Cu}$ ( $^{67}\text{Zn}$ ), перспективность которой для решения указанной задачи была продемонстрирована нами при идентификации дырок в решетках  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  [7] и  $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$  [8]. Поскольку невозможна регистрация мессбауэровских спектров  $^{67}\text{Cu}$ ( $^{67}\text{Zn}$ ) в магнитно-упорядоченных матрицах и  $Nd_2\text{CuO}_4$  при  $T < 250$  К переходит в антиферромагнитное состояние, для контроля за изменением параметров тензора ГЭП в узлах меди мы дополнительно использовали эмиссионный вариант мессбауэровской спектроскопии на изотопе  $^{61}\text{Cu}$ ( $^{61}\text{Ni}$ ).

## 1. Методика эксперимента

Синтез керамик  $Nd_2\text{CuO}_4$  и  $Nd_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  приводили путем спекания соответствующих оксидов на воздухе (при 950 и 1120°C) с последующим отжигом в аргоне (при 900°C). Радиоактивные изотопы  $^{61}\text{Cu}$  и  $^{67}\text{Cu}$  вводили в керамику методом диффузационного легирования при 900°C в течение часа. Контрольные образцы были однофазными, и для керамики  $Nd_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  получено  $T_c = 22$  К.

Мессбауэровские спектры  $^{61}\text{Cu}$ ( $^{61}\text{Ni}$ ) и  $^{67}\text{Cu}$ ( $^{67}\text{Zn}$ ) снимались соответственно при 80 и 4.2 К с поглотителями  $\text{Ni}_{0.86}\text{V}_{0.14}$  и  $\text{ZnS}$ . Типичные спектры приведены на рис. 1,2, а результаты их обработки сведены в таблицу.

## 2. Экспериментальные результаты

Мессбауэровский спектр образца  $Nd_{1.85}\text{Ce}_{0.15}^{67}\text{CuO}_4$  представляет собой хорошо разрешенный квадрупольный триплет, отвечающий

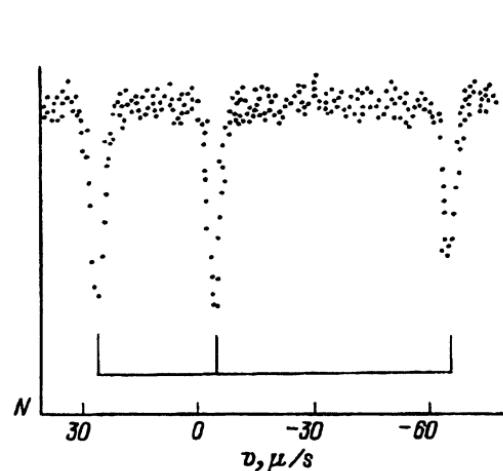


Рис. 1. Эмиссионный мессбауэровский спектр  $Nd_{1.85}\text{Ce}_{0.15}^{67}\text{CuO}_4$  при 4.2 К. Показано положение компонент квадрупольного триплета.

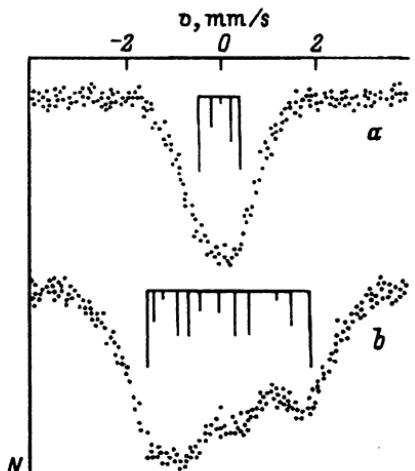


Рис. 2. Эмиссионные мессбауэровские спектры  $Nd_2^{61}\text{CuO}_4$  (a) и  $Nd_{1.85}\text{Ce}_{0.15}^{61}\text{CuO}_4$  (b) при 80 К. Показано положение компонент соответствующих мультиплетов.

Параметры эмиссионных мессбауэровских спектров  
 $^{61}\text{Cu}$ ( $^{61}\text{Ni}$ ) и  $^{67}\text{Cu}$ ( $^{67}\text{Zn}$ ) керамик  $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$

Состав керамики	$^{61}\text{Ni}^{2+}$ , 80 К			$^{67}\text{Zn}^{2+}$ , 4.2 К	
	$e^2Qq$ , MHz	$H$ , T	$\theta^\circ$	$e^2Qq$ , MHz	$N$
$\text{Nd}_2\text{CuO}_4$	-43	10.0	80		
$\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$	-43	0.0		15.3	< 0.2
Погрешность	$\pm 2$	$\pm 0.5$	$\pm 10$	$\pm 0.3$	

П р и м е ч а н и е.  $e^2Qq$  — постоянная квадрупольного взаимодействия,  $N$  — параметр асимметрии,  $H$  — магнитное поле на ядре  $^{61}\text{Ni}$ ,  $\theta$  — угол между направлением магнитного поля и главной осью тензора ГЭП.

единственному состоянию дочерних атомов  $^{67}\text{Zn}^{2+}$  в узлах меди. Поскольку для ионов  $\text{Zn}^{2+}$  отсутствует вклад в ГЭП на ядрах  $^{67}\text{Zn}$  от валентных электронов, то по соотношению

$$eq = (e^2Qq)/\{(1-\gamma)eQ\}$$

мы определили экспериментальную величину главной компоненты тензора ГЭП на ядрах  $^{67}\text{Zn}$  в узлах меди решетки  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$ :  $eq = 0.199 \pm 0.003 \text{ e}/\text{\AA}^3$  (при этом использованы следующие значения: для коэффициента Штернхаймера иона  $\text{Zn}^{2+}$   $\gamma = -12.2$  [9], для квадрупольного момента ядра  $^{67}\text{Zn}$   $Q = 0.17 \text{ barn}$  [10]).

Мессбауэрские спектры керамик  $\text{Nd}_2^{61}\text{CuO}_4$  и  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}^{61}\text{CuO}_4$  представляют собой типичные картины соответственно комбинированного (зеемановского и электрического квадрупольного) и чисто квадрупольного расщепления ядерных уровней зонда  $^{61}\text{Ni}^{2+}$ , находящегося в медных узлах решетки. Существенно, что переход от  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$  к  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  не сопровождается заметным изменением величины  $e^2Qq$  для центров  $^{61}\text{Ni}^{2+}$  (см. таблицу).

### 3. Обсуждение экспериментальных результатов

Таким образом, в отличие от экспериментов ЯМР на изотопе  $^{63}\text{Cu}$  в  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  [2,5,6] для зондов  $^{67}\text{Zn}^{2+}$  и  $^{61}\text{Ni}^{2+}$  в узлах меди наблюдается отличное от нуля квадрупольное взаимодействие. Для зонда  $^{61}\text{Ni}^{2+}$  ГЭП создается как ионами кристаллической решетки, так и валентными электронами самого иона  $\text{Ni}^{2+}$ , тогда как для  $^{67}\text{Zn}^{2+}$  вклад валентных электронов отсутствует. Поэтому отличная от нуля величина  $e^2Qq$  для  $^{67}\text{Zn}$  свидетельствует о ненулевом кристаллическом ГЭП, что справедливо для любого зонда в узлах меди решетки  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$ . С другой стороны, одинаковые значения  $e^2Qq$  для  $^{61}\text{Ni}$  в керамиках обоих составов свидетельствуют, по-видимому, о неизменности как валентной, так и кристаллической составляющей ГЭП. Первое относится только к зонду  $\text{Ni}^{2+}$ , а второе верно для любого зонда в узлах меди.

Мы провели расчет тензора ГЭП, создаваемого в узлах меди ионами кристаллической решетки  $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$  ( $x = 0$  и  $0.15$ ). Координаты атомов в элементарной ячейке брались согласно [11], а постоянные

решетки — согласно [12] (для  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$ ) и [13] (для  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$ ). Решеточные суммы подсчитывались на ЭВМ, суммирование проводилось внутри сферы радиуса 30 Å. Тензор ГЭП оказался аксиально-симметричным, и его главная ось совпадает с кристаллографической осью  $c$ . Для  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$  расчет был проведен для модели  $\text{Nd}^{3+}\text{Cu}^{2+}\text{O}_4^{2-}$ :  $eq_{cr} = 0.7906 \text{ e}/\text{\AA}^3$ . Для  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  расчет был проведен для трех моделей, различающихся местом локализации компенсирующего отрицательного заряда, появляющегося при аливалентном замещении ионов  $\text{Nd}^{3+}$  на  $\text{Ce}^{4+}$ : заряд равномерно распределен по узлам меди,  $eq_{cr} = 0.7888 \text{ e}/\text{\AA}^3$ ; заряд равномерно распределен по узлам кислорода, находящимся в одной плоскости с атомами меди,  $eq_{cr} = 0.7680 \text{ e}/\text{\AA}^3$ ; заряд равномерно распределен по узлам кислорода, находящимся вне указанной плоскости,  $eq_{cr} = 0.8241 \text{ e}/\text{\AA}^3$ ; при этом заряд неодимовой подрешетки принимался равным +3.075 e (e — заряд электрона).

Как видно, ни для одной из моделей не наблюдается количественного согласия расчетных  $eq_{cr}$  и экспериментальных  $eq$  значений главной компоненты тензора ГЭП. Согласование этих величин может быть достигнуто путем уменьшения либо коэффициента Штернхеймера для ионов  $\text{Zn}^{2+}$ , либо заряда всех ионов кристаллической решетки. Однако в этом случае исчезает однозначность в интерпретации экспериментальных результатов для зонда  $^{67}\text{Zn}^{2+}$ .

Именно поэтому при дальнейшем изложении мы используем лишь фундаментальный факт, следующий из эмиссионных месбауэровских спектров: отличие от нуля значений главной компоненты тензора ГЭП для центров  $^{67}\text{Zn}^{2+}$  и  $^{61}\text{Ni}^{2+}$  в узлах меди решетки  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$ . Как следует из наших расчетов тензора ГЭП, переход от  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$  к  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  для всех моделей распределения компенсирующих центров не сопровождается существенным изменением  $eq_{cr}$ , и это подтверждает вывод, сделанный выше из спектров  $^{61}\text{Cu}$ ( $^{61}\text{Ni}$ ). Иными словами, исчезновение квадрупольного взаимодействия в спектрах ЯМР  $^{63}\text{Cu}$  для  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  [2,5,6] нельзя объяснить перестроением локального окружения атомов меди, и, очевидно, для такого объяснения следует учесть изменение электронной структуры центров меди при переходе от  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$  к  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$ .

Действительно, в общем случае для центров с несферической валентной оболочкой (например,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $3d^9$ ) суммарный ГЭП на ядрах  $eq$  создается ионами кристаллической решетки  $eq_{cr}$  и валентными электронами центра  $eq_{val}$

$$eq = (1-\gamma)q_{cr} + (1-R_0)q_{val},$$

причем, как правило,

$$|(1-R_0)q_{val}| > |(1-\gamma)q_{cr}|,$$

а вклады от ионов решетки и валентных электронов различаются по знаку (здесь  $\gamma$ ,  $R_0$  — коэффициенты Штернхеймера для центра  $\text{Cu}^{2+}$ ).

Следовательно, уменьшение  $eq$  на ядрах  $^{63}\text{Cu}$  при переходе от  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$  к  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  можно объяснить только заметным уменьшением вклада в ГЭП на ядрах  $^{63}\text{Cu}$  от валентных электронов меди.

Такое изменение возможно, только если электронный заряд распределен по медной подрешетке.

Оценку изменения валентного вклада  $(1-R_0)e^2Qq_{\text{val}}$  для центров меди при переходе от  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$  к  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$  можно провести следующим образом. Из спектров ЯМР  $^{63}\text{Cu}$  для  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$  следует  $|e^2Qq| = 28.2 \text{ MHz}$  [3,4]. В  $\text{Nd}_2\text{CuO}_4$  медь находится в состоянии  $\text{Cu}^{2+}$ , и если использовать для  $\text{Cu}^{2+}$  значения  $\gamma = -28$  [14],  $Q = -0.211 \text{ barn}$  [15], а также вычисленное нами выше для  $\text{Nd}_2^{3+}\text{Cu}^{2+}\text{O}_4^{2-}$  значение  $eq_{\text{cr}} = 0.791 e/\text{\AA}^3$ , то получается  $(1-\gamma)e^2Qq_{\text{cr}} = -168.4 \text{ MHz}$  и, следовательно,  $(1-R_0)e^2Qq_{\text{val}} = 196.6 \text{ MHz}$ . Для  $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$ , согласно [2,5,6],  $e^2Qq = 0$ , а наши расчеты для модели с избыточными электронами, распределенными по медной подрешетке, дают  $eq_{\text{cr}} = 0.789 e/\text{\AA}^3$ ,  $(1-\gamma)e^2Qq_{\text{cr}} = -168 \text{ MHz}$  и, следовательно,  $(1-R_0)e^2Qq_{\text{val}} = 168.0 \text{ MHz}$ . Иными словами, переход от  $\text{Nd}_2^{3+}\text{Cu}^{2+}\text{O}_4^{2-}$  к  $(\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15})^{3.075+}\text{Cu}^{1.85}\text{O}_4^{2-}$  сопровождается уменьшением вклада в константу квадрупольного взаимодействия от валентных электронов меди на 28.6 MHz. Оценку этой величины можно получить также независимым путем, если предположить, что валентный вклад прямо пропорционален числу дырок на 3d-оболочке, обращаясь в нуль для электронной конфигурации  $3d^{10}$ . Тогда уменьшение  $(1-R_0)e^2Qq_{\text{val}}$  при изменении конфигурации меди от  $\text{Cu}^{2+}$  до  $\text{Cu}^{1.85+}$  должно составлять 29.5 MHz, что практически совпадает со значением 28.6 MHz, полученным выше из данных ЯМР на  $^{63}\text{Cu}$ .

Согласно [6], величина  $e^2Qq$  для  $^{63}\text{Cu}$  слабо зависит от состава  $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$  при малых  $x$ , а затем скачком уменьшается до нуля при  $x = 0.15$ . Такое поведение может быть описано на основе представлений о взаимном расположении зоны десятого 3d-электрона меди и донорной полосы церия. Предположение о том, что при малых  $x$  примесная полоса церия находится ниже пустой d-зоны меди, с увеличением  $x$  приближается к ней, а при  $x = 0.15$  они пересекаются, объясняет не только данные ЯМР, но и разрушение антиферромагнитного порядка при  $x = 0.15$ , а также существование сверхпроводимости только в узком интервале составов. Постоянство валентного вклада в ГЭП на ядрах  $^{61}\text{Ni}$ , т.е. электронной структуры ионов Ni в узлах меди, также можно объяснить в рамках этой модели, если поместить акцепторный уровень никеля, соответствующий перезарядке  $\text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni}^+$ , на несколько  $kT$  выше донорной полосы церия.

Таким образом, совокупность данных по экспериментальным и расчетным параметрам тензора ГЭП в узлах меди решетки  $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$  может быть объяснена, если предположить, что электроны, появляющиеся при аливалентном замещении ионов  $\text{Nd}^{3+}$  на  $\text{Ce}^{4+}$ , распределены по медной подрешетке. Это отличает соединения  $\text{Nd}_{2-x}\text{Ce}_x\text{CuO}_4$  от соединений  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  и  $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ , в которых дырки распределены по кислородным подрешеткам [7,8].

Работа поддержана Научным советом по проблеме «Высокотемпературная сверхпроводимость» в рамках проекта № 91139 «Резонанс».

## Список литературы

- [1] Tokura Y., Takadi H., Uchida S. // Nature. 1989. V. 337. P. 345–348.
- [2] Zheng G., Kitaoka Y., Oda Y., Asayama K. // J. Phys. Soc. Jap. 1989. V. 58. N 6. P. 1910–1913.
- [3] Kohori Y., Sagata T., Takenaka H., Kohara T., Yamada Y., Markert T., Maple M.B. // J. Phys. Soc. Jap. 1989. V. 58. N 10. P. 3493–3496.
- [4] Yoshihara Y., Yasuoka H., Shimizu T., Takadi H., Tokura Y., Uchida S. // J. Phys. Soc. Jap. 1990. V. 59. N 1. P. 36–39.
- [5] Kumagai K., Abe M., Tanaka S., Maeno Y., Fujita T. // J. Magn. and Magn. Mater. 1990. V. 90/91. P. 675–677.
- [6] Kambe S., Yasuoka Y., Takagi H., Uchida S., Tokura Y., // J. Phys. Soc. Jap. 1991. V. 60. N 2. P. 400–409.
- [7] Насрединов Ф.С., Мастеров В.Ф., Серегин Н.П., Серегин П.П. // ЖЭТФ. 1991. Т. 99. № 3. С. 1027–1040.
- [8] Seregin N.P., Masterov V.F., Nasredinov F.S., Saidov Ch.S., Seregin P.P. // Supercond. Sci. Technol. 1992. V. 5. N 2. P. 675–678.
- [9] Sternheimer R.M. // Phys. Rev. 1966. V. 146. N 1. P. 140–160.
- [10] Fuller G.H., Cohen V.W. // Nucl. Data. 1969. V. 5A. P. 433–440.
- [11] Yvon K., Francois M. // Z. Phys. B. 1989. V. 76. N 2. P. 413–440.
- [12] Matsuda M., Yamada K., Kakurai K., Kadouaki H., Thurston T.R., Endon Y., Hidaka Y., Birgeneau R.J., Kastner M.A., Gehring P.M., Moudden A.H., Shirana G. // Phys. Rev. B. 1990. V. 42. N 16. P. 10098–10107.
- [13] Sadowski W., Hagemann H., Francois M., Bill H., Peter M., Walker M., Yvon K. // Physica C. 1990. V. 170. N 2/3. P. 103–111.
- [14] Мастеров В.Ф., Насрединов Ф.С., Серегин Н.П., Серегин П.П., Saidov Ч.С. // Сверхпроводимость. 1992. Т. 5. № 10. С. 1830–1841.
- [15] Sternheimer R.M. // Phys. Rev. 1967. V. 167. N 1. P. 10–20.

Санкт-Петербургский государственный  
технический университет

Поступило в Редакцию  
25 ноября 1993 г.